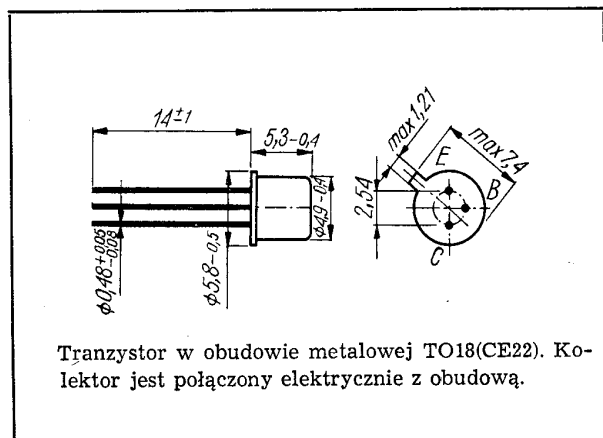


Tranzystory krzemowe epiplanarne przeznaczone do stosowania w układach przełączających małej i średniej mocy. Kolektor tranzystora jest połączony elektrycznie z obudową.



Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Kolektor jest połączony elektrycznie z obudową.

DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Typ		BSYP62	BSYP63
Napięcie kolektor-baza	U_{CB0}	25	40 V
Napięcie kolektor-emiter	U_{CE0}	15	15 V
Napięcie emiter-baza	U_{EB0}	5	5 V
Prąd kolektora	I_C	200	200 mA
Prąd bazy	I_B	20	20 mA
Moc strat	P_C	360	360 mW
Temperatura złącza	t_j	423 K (150°C)	
Zakres temperatury otoczenia	t_{amb}	233...373 K (-40...+100°C)	

TRANZYSTOR BSYP62

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		min.	maks.
Napięcie przebicia kolektor-baza			
przy $I_{CB0} = 10 \mu A$	$U_{(BR)CB0}$	25	— V
Napięcie przebicia kolektor-emiter			
przy $I_C = 30$ mA	$U_{(BR)CE0}$	15	— V
przy $I_C = 30$ mA, $R_{BE} = 10 \Omega$	$U_{(BR)CER}$	20	— V

Napięcie przebicia

emiter-baza			
przy $I_{EB0} = 10 \mu A$	$U_{(BR)EB0}$	5	— V
Prąd wsteczny kolektora			
przy $U_{CB0} = 15$ V	I_{CB0}	—	500 nA
przy $U_{CB0} = 15$ V, $t_{amb} = 373$ K (100°C)	I_{CB0}	—	20 μA
Prąd wsteczny emitera			
przy $U_{EB0} = 4$ V	I_{EB0}	—	100 nA
Napięcie nasycenia baza-emiter			
przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 1$ mA	U_{BEsat}	—	0,9 V
Napięcie nasycenia kolektor-emiter			
przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 10$ mA	U_{CEsat}	—	0,6 V
Współczynnik wzmocnienia prądowego			
przy $I_{C1} = 10$ mA, $U_{CE} = 1$ V,	h_{21E}	20	300 —
przy $I_C = 10$ mA, $U_{CE} = 1$ V, $t_{amb} = 298$ K (-40°C)	h_{21E}	10	— —

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		min.	maks.
Częstotliwość przeniesienia			
przy $I_C = 20$ mA, $U_{CE} = 10$ V	f_T	200	— MHz
Pojemność kolektora			
przy $U_{CB0} = 10$ V	C_C	—	6 pF
Czas włączania			
przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 3$ mA, $U_{BE} = 2$ V	t_{ON}	—	40 ns
Czas wyłączania			
przy $I_C = 10$ mA, $I_{B1} = 3$ mA, $I_{B2} = 1$ mA	t_{OFF}	—	75 ns

TRANZYSTOR BSYP63

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		min	maks.
Napięcie przebicia kolektor-baza			
przy $I_{CB0} = 10 \mu A$	$U_{(BR)CB0}$	40	— V

Napięcie przebicia kolektor-emiter				
przy $I_C = 30 \text{ mA}$	$U_{(BR)CE0}$	15	—	V
przy $I_C = 30 \text{ mA}$, $R_{BE} = 10 \Omega$	$U_{(BR)CER}$	20	—	V
Napięcie przebicia emiter-baza				
przy $I_{EB0} = 10 \mu\text{A}$	$U_{(BR)EB0}$	5	—	V
Prąd wsteczny kolektora				
przy $U_{CB0} = 15 \text{ V}$	I_{CB0}	—	100	nA
przy $U_{CB0} = 15 \text{ V}$, $t_{amb} = 373 \text{ K (100}^\circ\text{C)}$	I_{CB0}	—	15	μA
Prąd wsteczny emitera				
przy $U_{EB0} = 4 \text{ V}$	I_{EB0}	—	100	nA
Napięcie nasycenia baza-emiter				
przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $I_B = 1 \text{ mA}$	U_{BEsat}	—	0,8	V
Napięcie nasycenia kolektor-emiter				
przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $I_B = 10 \text{ mA}$	U_{CEsat}	—	0,4	V
Współczynnik wzmocnienia prądowego				

przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $U_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{21E}	30	120	—
przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $U_{CE} = 1 \text{ V}$, $t_{amb} = 298 \text{ K (-40}^\circ\text{C)}$	h_{21E}	15	—	—

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K (25}^\circ\text{C)}$		min.	maks.	
Częstotliwość przenoszenia				
przy $I_C = 20 \text{ mA}$, $U_{CE} = 10 \text{ V}$	f_T	300	—	MHz
Pojemność kolektora				
przy $U_{CB0} = 10 \text{ V}$	C_C	—	6	pF
Czas włączania				
przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $I_B = 3 \text{ mA}$, $U_{BE} = 2 \text{ V}$	t_{ON}	—	40	ns
Czas wyłączania				
przy $I_C = 10 \text{ mA}$, $I_{B1} = 3 \text{ mA}$, $I_{B2} = 1 \text{ mA}$	t_{OFF}	—	75	ns

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
PÓŁPRZEWODNIKÓWZakład Doświadczalny Półprzewodników przy ITE
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa
telefon: 431431 do 39, teleks: 813219